

## Skull 법에 의한 Cubic Zirconia 단결정 성장

김석호 · 최종건 · 오근호

조영환\* · 김영준\* · 오봉인\* · 강원호\*

한양대학교 무기재료공학과

\*삼성코닝 주식회사

(1988년 1월 12일 접수)

## Single Crystals Growth of Cubic Zirconia by Skull Method

S. H. Kim, J. K. Choi, K. K. Orr

Y. H. Cho\*, Y. J. Kim\*, B. I. Oh\*, W. H. Kang\*

Dept. of Inorg. Mat. Eng. Hanyang Univ.

\*Samsung Corning Co.

(Received January 12, 1988)

### 요약

6 ~ 15 mole %의  $\text{Y}_2\text{O}_3$  함량변화에 따라 Skull 용융법으로 Cubic Zirconia 단결정을 성장시켰다.

Skull 바닥면에서의 핵생성과 최적성장조건을 고찰하였으며 변화된  $\text{Y}_2\text{O}_3$  함량에 따라 얻어진 입방정상의 안정한 영역과 산소공급에 의한 결정의 변색과 서냉효과를 비교 검토하였다. 두명하고 안정한 입방정상의 결정은 8 ~ 11 mole %의  $\text{Y}_2\text{O}_3$  함량일때 얻어졌고  $\text{Y}_2\text{O}_3$ 를 12 mole % 이상 첨가시의 결정의 변색은 공기중 1200 °C에서 24시간 동안 서냉함으로서 제거할 수 있었다.

### ABSTRACT

Yttria-Stabilized Cubic Zirconia Crystals with Various  $\text{Y}_2\text{O}_3$  amounts (6-15 mol%) were grown by the Skull melting technique.

The modeling of the nucleation at the Skull bottom and the best growth condition were studied. The abrupt changes in generator heating Power and lowering rate of crucible caused the dendritic growth in the grown crystal. The optimum condition of cubic Zirconia single crystals was obtained when the lowering rate was gradually increased.

The effect of  $\text{Y}_2\text{O}_3$  amounts on the perfection and the color of the grown crystal were determined. The darkish color generated in the crystals added  $\text{Y}_2\text{O}_3$  amounts over 12mol% was eliminated by the annealing in air at 1200°C for 24 hrs.

### I 서 론

Zirconia는 난용성과 열충격 저항성 및 화학적 안정

성이 매우 우수하여 상면대와 결정구조, 안정화 기구 및 기계적, 전기적 특성이 폭넓게 연구되어 지고 있는 물질이다.

아마 아는 바와 같이 Zirconia의 가열, 냉각시 단사정  $\Leftrightarrow$  정방정의 상변태로 인하여 생기는 약 4~7%의 용적변화는<sup>(1)</sup> CaO, MgO, Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CeO<sub>2</sub>, Sc<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 등의 Zr<sup>4+</sup> 보다 낮은 원자자를 갖는 금속 이온의 산화물을 첨가함으로서 고온상인 입방정을 상온에서도 안정하게 유지시킬 수 있다.<sup>(2)</sup> 부분 안정화 ZrO<sub>2</sub>(PSZ)는 stress-induced Martensite 변태를 이용하여 파괴인성과 강도를 증진시켜 구조용 재료로 사용하고 있는<sup>(3)</sup> 반면에 완전 안정화 ZrO<sub>2</sub>(FSZ)는 높은 ionic conductivity를 갖는 재료로서 고체 전해질<sup>(4)</sup>이나 산소센서 등으로 응용되며 특히 단결정으로는 고구려, 고투과율, 고분산율, 고강도를 이용하여 Diamond 대치품<sup>(5,6)</sup>이나 렌즈, 적외선 window, 프리즘, 레이저 할진봉 등으로 사용되어 진다. 최근에는 접착회로의 기판용으로 사용하려는 연구와 적절한 열처리를 통해 결정내에 미세한 정방정상을 균일하게 석출시켜 구조용 재료로 사용하는 연구도 진행되고 있다.<sup>(7,8)</sup>

이와 같이 Cubic Zirconia 단결정은 뛰어난 열적<sup>(9)</sup> 전기적<sup>(10)</sup>, 광학적<sup>(11)</sup>, 기계적<sup>(12)</sup> 특성으로 인해 많은 연구가 진행되고 있다.

그러나 이런 우수한 특성들에도 불구하고 매우 높은 용점 ( $\approx 2750^{\circ}\text{C}$ )으로 인하여 종래의 결정 성장법으로는 양질의 대형 Cubic Zirconia 단결정을 성장시킬 수 없었다.

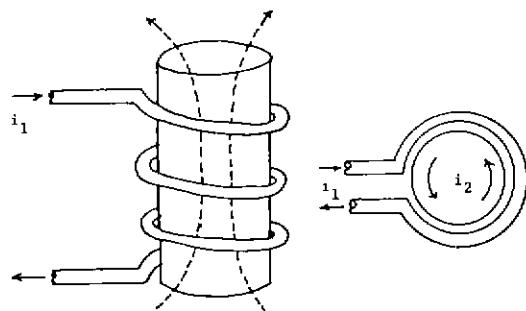
본 연구에서는 고주파 유도가열에 의한 skull 용융법 (Directional Solidification Method)<sup>(13,14)</sup>에 의하여 양질의 단결정을 성장시켰다. 또한 안정제로 MgO나 CaO를 첨가할 때는 입방정이 준안정하게 되지만 Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 첨가할 때는 입방정상이 넓은 조성영역에 걸쳐 안정하게 생성되며 광학적 특성이 우수하게 된다. 따라서 Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 안정제로 사용하여 6~15 mole %를 첨가하여 결정을 성장시켰다.

본 연구를 통해서 결정성장시 핵생성 과정과 결정성장에 미치는 도가니의 하강속도와 발진부의 가열출력의 영향을 고찰하였고 결정의 색에 대한 서냉 효과를 조사하여 양질의 단결정을 얻고자 하였다.

## II 실험방법

### II - 1 Skull 용융법

고주파 유도가열식 용융의 원리는 다음 Fig. 1과 같다. 시료 주변의 work coil로 전류 i<sub>1</sub>이 흐르게 되면 시료 내부에 유도전류 i<sub>2</sub>가 i<sub>1</sub>의 반대 방향으로 흐르게 된다. 이때 i<sub>1</sub>이 고주파 전류가 될수록 유도전류 i<sub>2</sub>는 시료의 표면에 집중되어 흐르는 현상이 나타



$$\delta = 503 \sqrt{\rho / \mu f} \text{ (mm)} \quad : \text{Skin Depth}$$

Fig. 1. Principles of induction heating.

난다. 이 현상을 표피효과 (skin effect)라고 하며 이 효과에 나타난 에너지 집중을 재료의 저항을 ρ와 비 투자율 μ와 전원 i<sub>1</sub>의 주파수 f의 함수인 침투깊이 (penetration depth) δ로 정의한다.

본 실험에서는 냉각수로 냉각되는 도가니 안에 분말을 충진하고 고주파로 유도시켰다. skull은 냉각수에 의해 강제로 냉각되는 도가니 밖면의 분말체로서 그 자체가 도가니의 구실을 하게 된다.

이와 같은 skull 법은 기존의 용액 성장법에서 제한요소인 고온에서의 도가니 사용과 불순물 함입을 해결하였고 온도에 제한이 없으므로 고용-용점 블질의 결정 성장에 응용되어 왔다.<sup>(14,15)</sup>

### II - 2 단결정 성장장치

결정 성장장치는 크게 고주파 빌진장치, 도가니 하강장치, 냉각장치로 나눌 수 있다. 고주파 빌진장치는 진공관 발진형으로 2~6 MHz의 고주파와 50 kw의 출력을 공급하도록 제작되었다. Fig. 2는 도가니와 하강장치의 도식적인 그림이다. 도가니 ([높이 10 cm, 내부반경 8 cm]과 [높이 20 cm, 내부반경 18 cm])는 냉각수에 의해 냉각되며 고준도의 둘로 만들어 젖고 자장이 통과할 수 있도록 틈을 만들어 자체유도를 막지하고 내부 시료의 가열과 skull의 형성을 용이하게 하도록 제작되었다. 하강장치는 결정성장시 1~50 mm/hr의 속도로 기계적 진동없이 일정하게 하강되도록 제작하여 용액과 결정사이의 안정한 계면을 얻을 수 있었다. 냉각장치는 고주파 발진부와 도가니가 일정한 온도로 유지되도록 냉각탑을 통과한 냉각수를 각 부위에 공급하도록 설계되었다. 각 장치에 공급되는 냉각수의 유량은 유속과 유압으로 조절하였다.

### II - 3 원료 분말의 준비와 충진

본 실험에서는 출발원료로 결정 성장용 99.99% 의

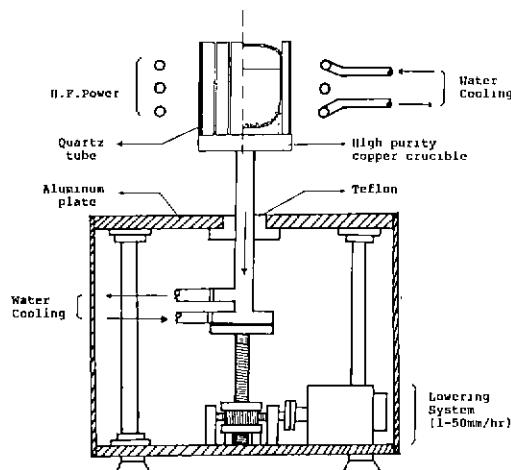


Fig. 2. Schematic diagram of skull melting equipment.

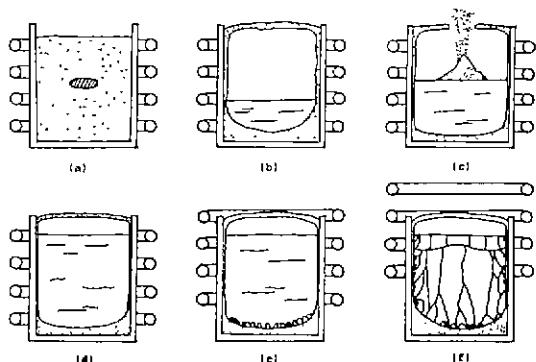


Fig. 4. Process of melting and crystallization in the crucible.

(a) (b) (c) Melting and recharging (d) Melt homogenization (e) Nucleation (f) Growing and annealing

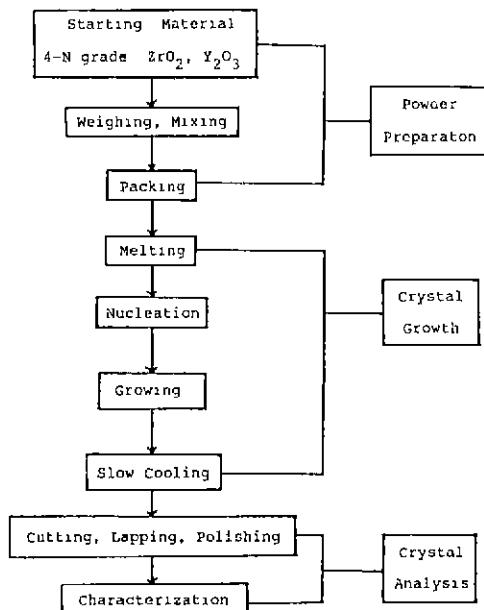


Fig. 3. Schematic diagram of experimental procedure

고순도  $ZrO_2$  와  $Y_2O_3$  시약을 사용하였다.  $ZrO_2$ 와  $Y_2O_3$ 를 6~15 mol % 첨가하여 용기에 넣은 뒤 5~6 시간동안 건식 혼합하였다.

#### II - 4 결정 성장 과정

결정성장을 Fig. 4의 같이 용융, 용액 균질화, 혼생성, 결정성장의 순서로 행하였다.

원료가 충진된 도가니를 work coil의 중앙에 놓은 뒤에 고주파의 출력을 올려주면 온도증가에 따라 시료

의 전기전도도가 증가하여 도체의 역할을 하게 되어 금속과 같은 유도가열이 가능해 진다.

계속적인 가열로 인해 skull 중앙의 시료가 용융되어 질때, 적외선 광고온계로 용액의 온도를 측정한 결과  $3000^{\circ}C$  가 넘는 과열된 용액임을 알게 되었다. 용액을 2~3시간 유지시켜 균질화시키고 뒤에 하강속도의 미세조절로 혼생성을 일으킨다. 이때에 도가니를 서서히 하강시켜 용액내에 수직방향으로 온도구배를 주면 바닥의 핵들이 우선 성장하게 된다.

#### II - 5 결정 분석

Skull 중심부에 걸친 자란 단결정 column을 결정 절단기를 사용하여 성장방향에 수직으로 잘라 두께 2 mm의 얇은 slice로 만든 뒤에 SiC 분말 # 1000, # 2000 # 4000의 순서로 연마하고 입도  $0.25 \mu m$ 의 diamond paste로 경연연마를 행한 뒤에 Laue 사진기로 얻은 Laue back reflection pattern을 분석하여 성장방위를 구하였다.

$Y_2O_3$ 를 6~15 mole % 첨가하여 성장시킨 결정의 아랫 부분을 분쇄하여 X-ray diffractometer (Philips사, No. PW 1700, 40 kV, 30 mA, Scan speed  $1.5^{\circ}/min$ , CPS 20,000, time const. 1)를 사용하여 CuK $\alpha$ 선과 Ni filter로  $2\theta = 25\sim 60^{\circ}$ 의 범위에서 X 선 회절분석을 수행하여 첨가된  $Y_2O_3$  물질에 따른 격자상수의 변화를 구하였다.

서냉효과를 알아보기 위해  $Y_2O_3$  함량이 12mole %인 결정을 Laue 분석용 시편과 같은 방법으로 시편제작하여 colorimeter (Yasuda Seiki 사, No. 600 UC-IV)로 색을 측정하였고 이 시편을 공기중  $1200^{\circ}C$ 에서 24시간동안 서냉한 뒤에 측정한 값과 비교하였다.

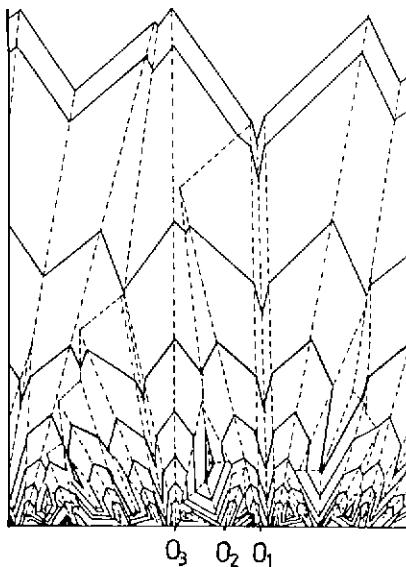


Fig. 5. Modeling of nucleation by the geometric selection.

### III 결과 및 고찰

#### III - 1. 결정성장

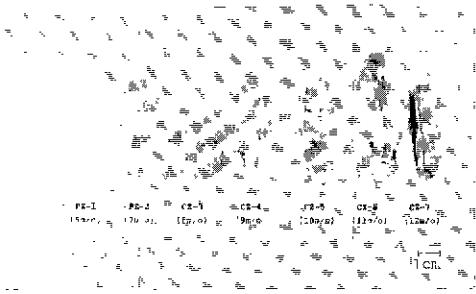
##### 1 - 1 핵생성

일반적인 용액성장법과는 달리 skull 법에서는 용액과 접한 skull 바닥면의 소성체의 분말이 다양한 방향을 갖는 희의 구실을 할 수 있는 것이 특징이다.

핵생성시 용액을 향해 성장하는 미세결정중에서 가장 빠른 성장방향이 성장계면에 수직할때 결정이 계속 성장하게 되고 나머지는 성장이 중단되어 소멸된다.

Fig. 5는 이러한 기하학적인 선택에 의해서 Cubic Zirconia의 결정핵들이 형성되어 가는 과정의 모식도이다. 입의의 방향을 갖는 미세결정이 핵생성 계면위의 점 O<sub>1</sub>과 O<sub>2</sub> 위에 동시에 형성되었을 때 계면에 수직 방향으로의 결정 O<sub>1</sub>의 성장속도는 결정 O<sub>2</sub>에 비해 더 빠르게 된다. 결과적으로 단위시간내에 결정 O<sub>1</sub>은 결정 O<sub>2</sub> 보다 계면으로부터 더 높이 자리에 된다. 따라서 결정 O<sub>2</sub>는 결정 O<sub>1</sub>과 O<sub>3</sub> 사이에서 성장이 중단된다. 결정성장이 더 진행되면 결정 O<sub>1</sub>은 수직에 보다 가까운 성장축을 갖는 O<sub>3</sub>에 의해 성장이 중단되어 소멸된다.

이와 같은 핵생성 모델은 Lemmelein<sup>(14)</sup>에 의한 것으로 실제 핵생성과정중에 결정을 떼분 하강속도로 성장시켰을때 위와 같은 기하학적 선택의 양상이 결정 전반부에 걸쳐 나타나는 것을 알 수 있었다. 핵생성시 유



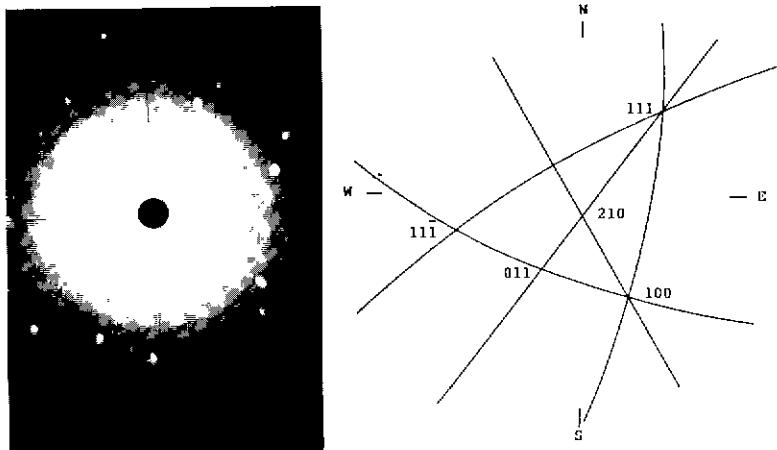


Fig. 7. Growth direction determination by the Laue technique.

제 2 상이 상부에 집중하는 것은  $ZrO_2$ 에 대한  $Y_2O_3$ 의 편석계수 (segregation coefficient) 가 1 보다 커서<sup>(13)</sup> 성장에 따라 합입되는  $Y_2O_3$ 의 양이 줄어들기 때문이다. 이것은 Fig. 10에서  $Y_2O_3$  함량이 12 mole % 일 때의 결정체 하부의 상부의 격자상수 차이로도 확인 할 수 있었다. 제 2 상은 다수의 crack을 통반하였는데 이는 냉각에 따라 임방정에서 분리된 정방정이 단사정으로 변태 할 때의 체적변화 때문으로 생각된다.

위의 결과들로부터 양질의 Cubic Zirconia 단결정 성장을 위하여 8~11 mole % 의  $Y_2O_3$  함량이 적당함을 알 수 있었다.

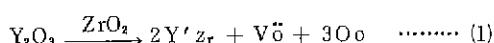
### III - 2 단결정의 특성

#### 2 - 1 성장방향

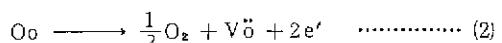
성장된 Cubic Zirconia 단결정의 방위를 결정하기 위해 Fig. 8과 같이 Laue back reflection pattern 을 얻어 Stereographic projection 으로 해석한 결과 성장된 결정방위는 [210] 이었다.

#### 2 - 2 서냉효과

$Y_2O_3$  함량이 12 mole % 이상이었거나 온도상대에서 금냉된 결정들에서는 어두운 색이 나타났다. 이러한 현상은 Zr 대신 Y가 치환됨에 따라 산소가 부족해지고 금냉시에는 저온으로 인해 산소의 확산이 힘들어지기 때문에 결정내에 생성되는 산소공공 때문으로 생각된다.<sup>(14)</sup> 격자내의 공공의 생성과정은<sup>(15)</sup> 다음식 (1)과 같이 나타낸다.



이때  $ZrO_2$ 는  $Po_2$  와 온도에 따라 식(2)와 같이 산소부족이 된다.



12 mole % 이상의  $Y_2O_3$  가 첨가되었을 때는 식 (1)을 따라서, 금냉된 경우는 식 (2)를 따라 산소공공이 생성되고 결정내부에 전기적 중성을 이루기 위해 전자가 포획되어 color center 를 이루는 것으로 생성되어 진다.

Table 2 는 서냉전후의 결정의 색채를 CIE 표색계로 비교한 것이다.

서냉한 뒤 시원의 색채가 보다 투명해 진 것을 알 수 있다. 이것은 서냉으로 인해 산소공공에 산소가 확산되어 들어가 color center 가 소멸된 것으로 생각된다. 이것은 진공중 서냉후에 더 어둡게 먼색 되었다는 문헌<sup>(16, 20, 21)</sup> 으로도 확인할 수 있다.

## VI 결 론

1. Skull 바닥면에서의 핵생성은 핵들의 방향과 형태에 따른 기하학적 선택에 의한다.

2.  $Y_2O_3$  를 8~11 mole % 첨가하고 하강속도를 3

Table 2. Color Difference in Sample(CZ-7) between before and after Annealing.

Annealing	Y (%)	x	y
Before	77.1	0.310	0.321
After	78.1	0.306	0.317
White standard sample	84.7	0.288	0.292

시간에 걸쳐 서서히 증가시킴으로서 양질의 Cubic Zirconia 단결정을 얻을 수 있었다.

3.  $\text{Y}_2\text{O}_3$  를 12 mole% 이상 첨가하였을 때 결정내에 어두운 색을 나타냈고 이것을 풍기중 1200°C에서 24시간동안 서냉함으로서 탈색시킬 수 있었다.

## REFERENCES

- T. K. Gupta, J. H. Bechtold, R. C. Kuznicki, L. H. Cadoff, and B. R. Rossing, "Stabilization of tetragonal phase in polycrystalline Zirconia", *J. Mat. Sci.*, **12**, 2421-26 (1977).
- P. S. Duwez, F. Odell, and F. H. Brown, "Stabilization of Zirconia with calcia and magnesia", *J. Am. Ceram. Soc.*, **35**(5), 107-13 (1952).
- D. L. Porter, A. G. Evans, and A. H. Heuer, "Transformation Toughening in Partially stabilized Zirconia (PSZ)", *Acta Metall.*, **27**(10), 1649-54 (1979).
- K. C. Radford, R. J. Bratton, "Zirconia electrolyte cells", *J. Mat. Sci.*, **14**, 66-69 (1979).
- K. Nassau, "Gems Made by Man", pp. 232-42, Chilton Book Co., Radnor, PA., 1980.
- K. Nassau, "Cubic Zirconia, The Latest Diamond imitation and skull melting", *Lapidary Journal*, **31**, 900-904, (1977).
- A. L. Lin, I. Golecki, "Influence of Growth Temperature on the Physical properties of Si films on Yttria-stabilized Cubic Zirconia Substrates", *J. Electrochem. Soc.*, **132**(1), 239-44 (1985).
- J. Lankford, "Deformation and Fracture of Yttria-Stabilized Zirconia Single Crystals", *J. Mat. Sci.*, **21**, 1981-89 (1986).
- V. I. Aleksandrov, R. G. Belyanina, V. A. Blokhim, Zh. I. Ievleva, V. V. Osiko, A. L. Shimkevich, and B. A. Shmatko, "Character of the conductivity of Fianites at 300-500°C", *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mat.*, **15**(9), 1619-23 (1979).
- S. P. S. Badwal, "Electrical conductivity of single crystal and polycrystalline Yttria-Stabilized Zirconia", *J. Mat. Sci.*, **19**, 1767-76 (1984).
- V. I. Aleksandrov, V. F. Kalabukhova, E. E. Lomonova, V. V. Osiko, and V. I. Tatarintsev, "Influence of imurities and annealing conditions on the optical properties of single crystals of  $\text{ZrO}_2$  and  $\text{HfO}_2$ ", *Izv. AKad. Nauk SSSR, Neorg. Mat.*, **13**(12), 2192-96 (1977).
- R. P. Ingel, R. W. Rice, and D. Lewis, "Room-Temperature strength and Fracture of  $\text{ZrO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$  Single Crystals", *J. Am. Ceram. Soc.*, **65**(7), C-108-C-109 (1982).
- A. Baerman, W. Guse, and H. Saalfeld, "Characterization of different  $(\text{Me}, \text{Zr})\text{O}_2$  single crystals Grown By the" Skull-Melting" Technique", *J. of Cryst. Growth*, **79**, 331-35 (1986).
- V. I. Aleksandrov, V. V. Osiko, V. M. Tatarintsev, and V. T. Udoenchik, "Melting refractory dielectrics by Direct High frequency heating in a "cold" container", *Izv. AKad. Nauk SSSR*, (2), 235-38 (1973).
- C. C. Herrick, R.G. Behrens, "Growth of Large  $\text{UO}_2$  and  $\text{ThO}_2$  single crystals from the melt using a cold-crucible Technique", *J. of Cryst. Growth*, **51**, 183-89 (1981).
- A. A. Chernov, "Modern crystallography; Crystal Growth", pp. 283-85, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1980.
- V. I. Aleksandrov, G. E. val' yano, B. V. Lukin, V. V. Osiko, A. E. Rautbort, V. M. Tatarintsev and V. N. Filatova, "Structure of single crystals of stabilized Zirconium dioxide", *Izv. AKad. Nauk SSR, Neorg. Mat.*, **12**(2), 273-77 (1976).
- V. B. Glushkova, V. V. Osiko, L. G. Shcherbakova, V. I. Aleksandrov, Yu, N, Paputskii, and V. M. Tatarintsev, "Characteristics of monocrystalline Solid Solutions

- in the system  $ZrO_2-Y_2O_3$ ”, Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mat., 13(2), 2197-2201 (1977).
19. M. Jayaratna, M. Yoshimura, S. Somiya, “Electrical conductivity of  $Cr_2O_3$ -doped  $Y_2O_3$ -Stabilized  $ZrO_2$ ”, J. Mat. Sci., 22, 2011-16 (1987).
20. V. I. Aleksandrov, S. Kh. Batygov, Yu. K. Voron’ko, B. I. Denker, E. E. Lomonova, V. V. Osiko, and V. M. Tatarintsev, “Color Centers in Single crystals of Cubic  $ZrO_2$ ”, Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mat., 11(4), 664-67 (1975).
21. V. I. Aleksandrov, S. Kh. Batygov, M. A. Vishyakova, Yu. K. Voron’ko, V. F. Kalabukhova, S. V. Lavishchev, E. E. Lomonova, V. A. Myzina, and V. V. Osiko, “Influence of composition and heat treatment on change states of Intrinsic and impurity defects in  $ZrO_2-Y_2O_3$  Solid Solution”, Sov. Phys. Sol. States, 26(5), 799-802 (1984).